

半导体激光

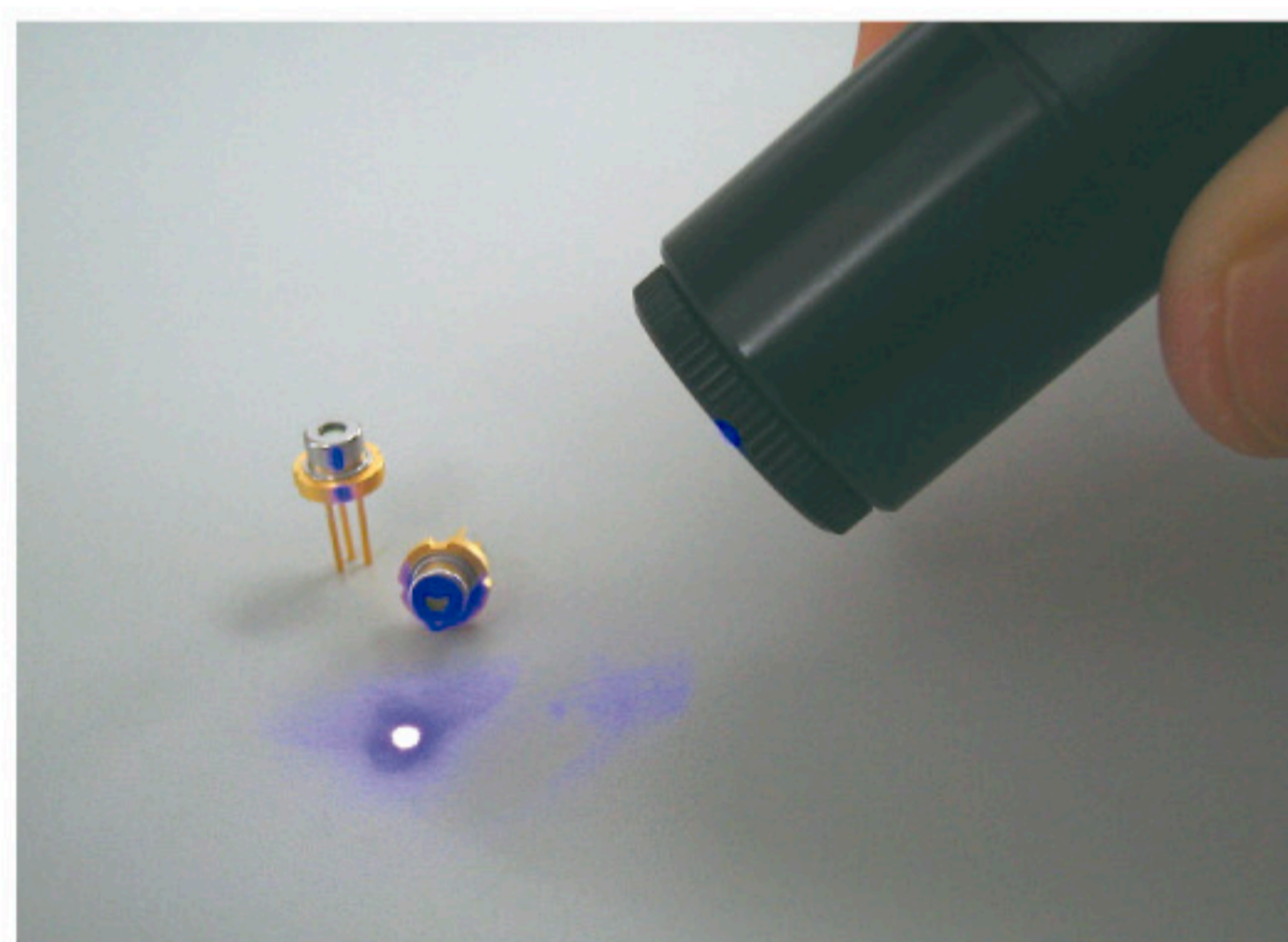
Laser Diode

高密度光盘记录用 高输出青紫色半导体激光

最大额定值 (Tc=25°C)

项目	记号	额定值	单位
光输出 (CW)	Po	100	mW
光输出 (脉冲) (注)	Po	200	mW
动作温度	Tc	-10~75	°C

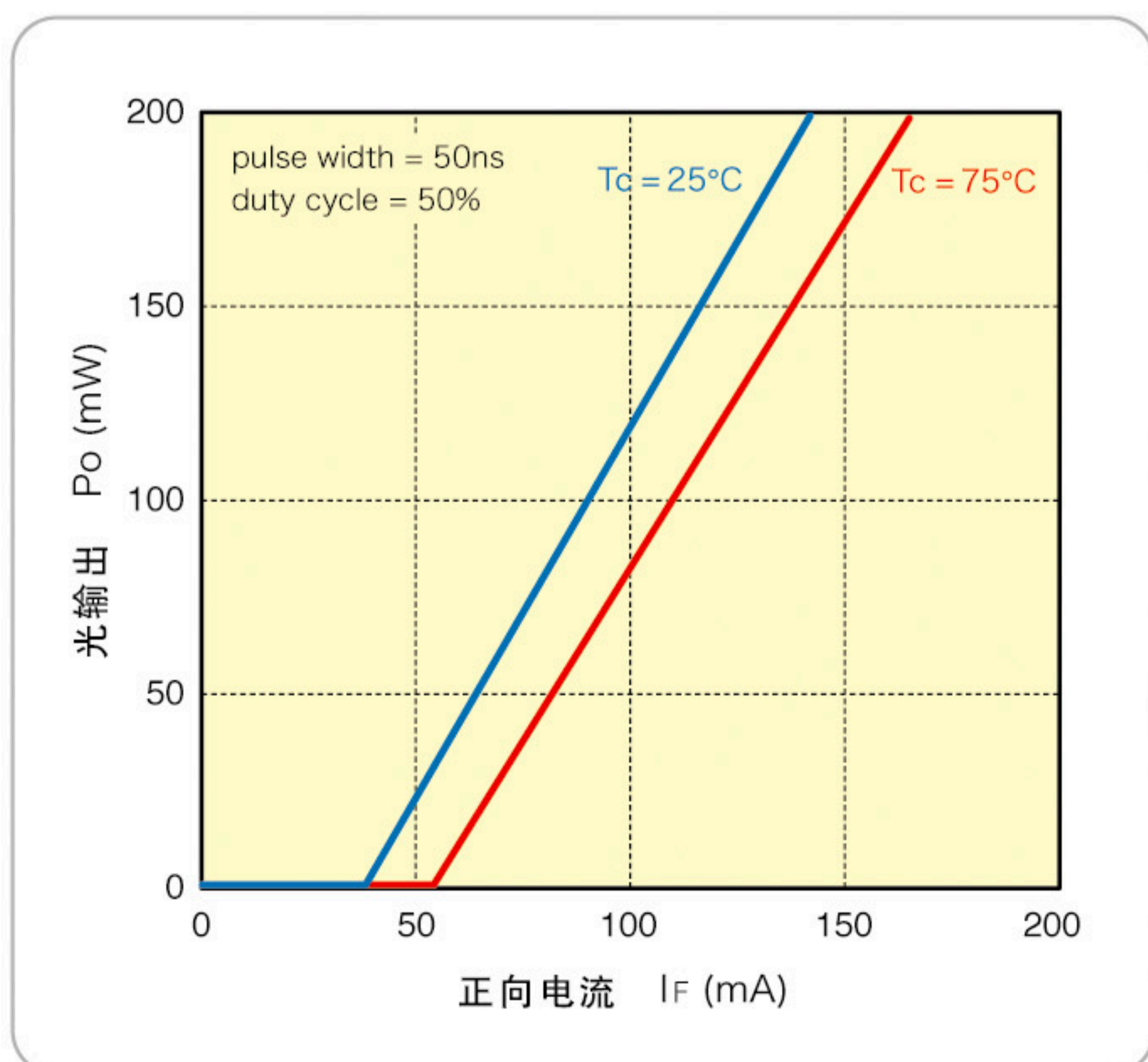
(注): pulse width = 50ns, duty cycle = 50%



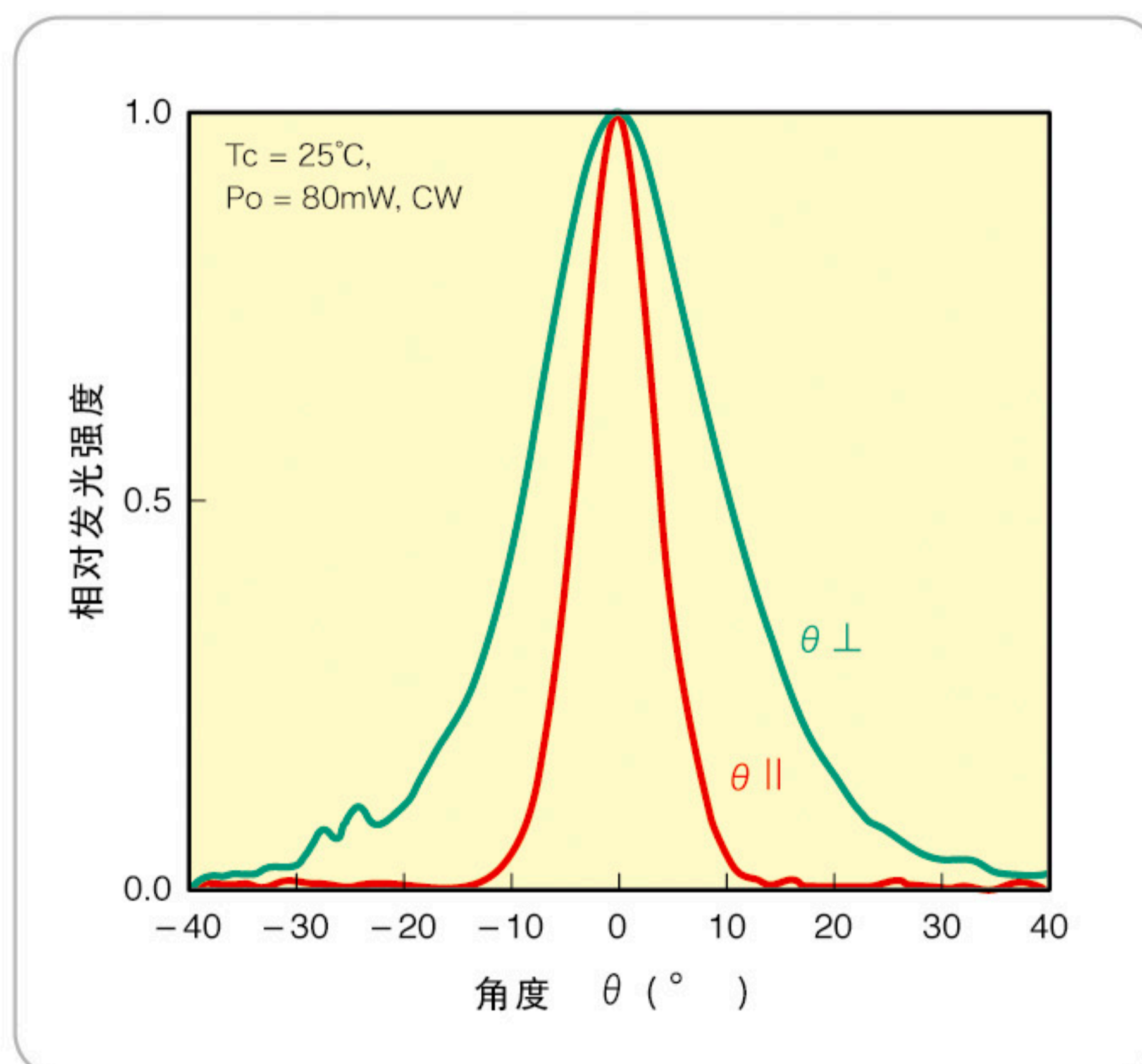
电气、光学特性(Tc=25°C)

项目	记号	测定条件	标准值	单位
阈值电流	I _{th}	CW动作	50	mA
动作电流	I _{op}	Po = 80mW (CW)	100	mA
动作电压	V _{op}	Po = 80mW (CW)	5	V
振荡峰值波长	λ _p	Po = 80mW (CW)	405	nm
光束发散角度	θ	Po = 80mW (CW)	9	°
	θ _⊥	Po = 80mW (CW)	21	°

脉冲I-L特性 (代表例)



远场图形 (代表例)



注) 本产品目前正在开发中, 因此规格会有更改。

* 记载的系统以及产品名一般都是各公司的注册商标或商标。